

## BJT 非理想特性

- (1) MOSFET 的高漏极电压区域称为饱和区。BJT 对应的区域叫什么？
- (A) 饱和区域
  - (B) 正向活动区域
  - (C) 反向有源区
  - (D) 截断区域
  - (E) 超夹断区域
- (2) MOSFET 的低漏极电压区域称为线性(或欧姆区，或三极管区)区域。BJT 对应的区域叫什么？
- (A) 饱和区域
  - (B) 正向活动区域
  - (C) 反向有源区
  - (D) 截断区域
  - (E) 超夹断区域
- (3) 对于 $\beta_{dc}(\beta_F)$ 而言，下列哪个值被认为比较合理？
- (A) 0.099
  - (B) 0.99
  - (C) 1.5
  - (D) 5
  - (E) 100
- (4) 对于 $\alpha_{dc}(\alpha_F)$ 而言，下列哪个值被认为比较合理？
- (A) 0.099
  - (B) 0.99
  - (C) 1.5
  - (D) 5
  - (E) 100
- (5) 下列哪一项会减少基宽调制？
- (A) 增加发射极掺杂
  - (B) 增加基极掺杂
  - (C) 增加集电极掺杂
  - (D) 降低发射极掺杂
  - (E) 降低基极掺杂
- (6) 在 BJT 中，最高掺杂，次高掺杂和最轻掺杂的顺序是什么？
- (A) 发射极、基极、集电极
  - (B) 发射极、集电极、基极
  - (C) 基极、集电极、发射极

- (D) 基极、发射极、集电极
- (E) 集电极、基极、发射极

(7) 要做一个好的 HBT, 哪层应该有一个宽的带隙?

- (A) 发射区
- (B) 基区
- (C) 发射区和基区
- (D) 衬底和收集区
- (E) 收集区